

半导体文摘

BANDAOTIWENZHAI

一九八五年度主题索引

科学技术文献出版社重庆分社

半 导 体 文 摘

一九八五年度主题索引

中国科学技术情报研究所重庆分所 编辑
科学技术文献出版社重庆分社 出版
重庆市市中区胜利路132号

新华书店重庆发行所 发行
科学技术文献出版社重庆分社印刷厂 印刷

开本：787×1092毫米1/16 印张：10.75 字数：37万
1986年8月第一版 1986年8月第一次印刷
科技新书目：131—294 印数：1300

书号：15176·727

定价：4.00元

使 用 说 明

1. 本索引包含材料主题索引（简称材料索引）和一般主题索引（简称主题索引）两种。所采用的主题词根据“汉语主题词表”并按本学科的需要补充拟定。
2. 本索引原则上采用一级主题词。为了便于查找类似的主题，在部分一级主题词下设立二级主题词。
3. 本索引中采用的几个简略词的意义如下：
 - 1) “用”表示采用另一个相当或相近的词作主题词，例如：光伏电池（用：太阳电池）
 - 2) “含”表示该主题词包含另一个相当或相近的主题词，例如：电子显微镜（含：电子显微术）
 - 3) “参”表示参见与该主题词相关的其他主题词；例如：MOS结构（参：MOS晶体管，MOS二极管）。
 - 4) “见”表示这个主题属于另一个主题下面的二级主题词。例如：电子衍射（见：衍射）
4. 主题词按汉语拼音字母音序排列。主题词不论一级还是二级的，均用黑体字排印。
5. 材料索引的主题词属元素符号和分子式者按英文字母音序排列，属汉字表示的材料名词者按汉语拼音字母音序排列。
6. 为了使读者了解本索引的主题词，特将材料主题词和一般主题词分别编成一览表单独列出。
7. 本索引中主题词后面的文摘号表示与该主题有关的文摘。读者查找某一课题资料时，可先根据该课题内容确定应查主题词表中的哪几个主题词。在这几个主题后的文摘号码相同的哪些篇文章即读者所要寻找的。
8. 为了便于读者从文摘号找出该条文摘，现将1985年半导体文摘各期的起迄文摘号列出如下：

第1期：	8500001	至	8501070
第2期：	8501071	至	8501988
第3期：	8501989	至	8502920
第4期：	8502921	至	8503638
第5期：	8503639	至	8504318
第6期：	8504319	至	8505318
第7期：	8505319	至	8506146
第8期：	8506147	至	8507125
第9期：	8507126	至	8508048
第10期：	8508049	至	8508871
第11期：	8508872	至	8509729
第12期：	8509730	至	8510614
10. 本年度索引由钱埙伯、何朝荣、董仪光、姜登岑编制。由于缺乏经验，而且时间仓促，难免存在各种缺点错误，敬希读者批评指正。

一九八五年度半导体文摘主题索引

目 录

材料词一览表	(1)
主题词一览表	(10)
材料索引	(34)
主题索引	(74)

材料词一览表

A..... (34)	Al/Ti Al/TiSi ₂ /Si AlAs AlAs-AlGaAs-GaAs AlAs-GaAs AlCl ₃ AlGaAs 半绝缘AlGaAs AlGaAs/GaAs (用: GaAs/ GaAlAs) AlGaAs-GaAs:Si-GaAs AlGaAsP AlGaAsSb AlGaInAs AlGaInP AlGaInP/GaInP AlGaN AlGaP (用: GaAlP) AlGaSb AlGaSb/GaSb AlInAs AlInAs/GaInAs AlN AlN/Al ₂ O ₃ Al ₂ O ₃ Al ₂ O ₃ -GaAs Al ₂ O ₃ -InP Al ₂ O ₃ /SiO ₂ AlP AlP _x O _y AlSb AlSe-TlSe Ar ArF As a-As-Ge-Se As-Sb 合金 AsCl ₃ AsCl-Ga-Ar AsCl ₃ -GaAs-H ₂ AsCl ₃ /Ga/H ₂ AsH ₃	As ₂ S ₃ a-As ₂ Se ₃ As ₂ (S, Se) As ₄ S ₄ As ₂ Se ₃ As ₂ Se ₃ a-As ₂ Se ₃ As ₄₀ Se ₅₀ Ag _x a-AsTe As ₂ Te ₃ As ₂ Te ₃ -As ₂ Se ₃ Au Au/AuGeNi/GaAs Au-Be Au-Be-Ge Au-Be-Si Au-Be-Sn Au/Cr Au-GaAs Au-GaP Au-Ge Au-Ge-Ag Au-Ge-In Au-Ge-Ni Au-InP Au-InSe Au/Ni/Au-Ge/GaP Au/Ni/AuGe Au/a-Se/Au Au-Si Au-Si-Be Au-Sn
		B..... (37)

B ₂ H ₆ -SiH ₄	CdS	Cl
Bi	CdS-CdSe	ClF ₃
Bi-Te	CdS/CdTe	Co
Bi ₂ O ₃ -GeO ₂	CdS/CuInSe ₂	Co-InP
Bi ₂ O ₃ -SiO ₂	CdS/Cu ₂ S	CoSi ₂
Bi ₂ S ₃	CdS/酞花青	CO
BiSb	CdS/三价金属酞青	CO ₂
BiSbTe	CdS/InP	Cr
Bi ₂ Se ₃	CdS/Si	Cr-Al/Cu
Bi ₂ Te ₃	CdSb	Cr/SiO ₂
Bi ₂ Te ₃ -La ₃ Te ₄	CdSb-NiSb	Cr-SiO ₂ -Si
Bi ₂ Te ₃ -Sb ₂ Te ₃	CdSiAs ₂	CrSi ₂
BN	CdSnAs ₂	Cs
a-BN	CdSTE	Cs-Te
B ₂ O ₃	CdSe	CsCdBr ₄
BP	a-CdSe	CsCdCl ₃
	CdSe-VO ₂	Cs ₂ CdI ₄
C..... (38)		Cs ₂ Se ₃
C	CdSSeCu	Cs ₂ (TCNQ) ₃
Ca	CdTe	Cs ₂ Te ₃
CCl ₄	多晶CdTe	Cu/Al
CCl ₄ /O ₂	CdTe-Bi	Cu/Cu ₂ O
CClF ₃ + H ₂	CdTe/HgCdTe	Cu/GaAs
CaF ₂	CdTe/HgTe	Cu-InP
Cd	CdTe-ZnTe	CuAl
Cd-Pb	CdTe/TIO	CuAlGaSe ₂
Cd-Te-N-H-I	CdTeSeS	CuAlSe ₂
Cd ₃ As ₂	CdZnAs	CuAlTe
多晶Cd ₃ As ₂	CdZnS	CuCr
Cd(CH ₃) ₂ -(CH ₃) ₂ Te-H ₂	CdZnS/CuInSe ₂	CuCr ₂ Se ₄
CdCl ₂ + CdS	CdZnTe	CuCr ₂ O ₄
CdCr ₂ Se ₄	Cf	CuGaInS ₂
CdGa ₂ Se ₄	CF ₄	CuGaSe ₂
CdGeAs ₂	CF ₄ /H ₂	CuGaS _{2x} Se _{2(1-x)}
CdGeP ₂	CF ₄ /O ₂	CuGaTe ₂
CdGeSe ₂ -CdSiSe ₂	CF ₄ /Si	Cu _{1/2} In _{1/2} Cr ₂ Se ₄
CdHgTe (用: HgCdTe)	C ₂ F ₆	CuInS ₂
CdInS	CFCl ₃	CuInSe ₂
CdMnSe	(C ₆ F ₅) _{3-n} Me _n Ga·AsEt ₃	a-CuInSe ₂
CdMnTe	C ₂ H ₄	CuInSe ₂ /CdS
CdO	(CH ₃) ₃ As	CuInSe ₂ /CuISe ₃
CdO-P ₂ O ₅	(CH ₃) ₃ In	CuInSe ₂ /ZnCdS
CdO-SiO ₂ -Si	(CH ₃) ₃ P	CuInTe
CdO-Sb ₂ O ₃	[ClMeGa·AsEt ₂]CH ₂	Cu ₂ O
Cd ₃ P ₂	[ClEt ₂ Ga·AsEt ₂]CH ₂	Cu ₂ O/Cu

Cu ₂ O/碘化物	GaAlAs/GaAs(用: GaAs/GaAlAs)	GaN
Cu-P	GaAlAs-GaAs-GaAlAs	GaN/AlN
Cu/a-Si:H/a-Si:H/Cr	GaAlInAs (用: AlGaInAs)	GaP
Cu-S	GaAlInAs/AlInAs	GaP/AlGaP
a-CuS	GaAlP	GaPAsSb
Cu _x S/CdS	GaAlSb	GaP(Fe)
Cu ₂ S/CdZnS	GaAlSbAs/GaAs	GaP-电解质
Cu _x S-CdZnS-CdS	GaAs	Ga ₂ S ₃ -Y ₂ O ₃
Cu _{2-x} X(X=S, Se)	a-GaAs	GaSb
Cu ₂ S-ZnCdS	a-GaAs:H	GaSb-AlSb
Cu _{2-x} Se	半绝缘GaAs	GaSb/GaAlAsSb
Cu ₂ Se-In ₂ Se ₃ -Se	多晶GaAs	GaSb-InAs-GaSb
Cu _{2-x} Se	GaAs-AlAs	GaSb-InSb
Cu ₃ Si	GaAs-C	GaSb(Se)
Cu ₂ -Te	GaAs/GaAlAs	GaSe
D..... (42)		
Dy	GaAs/GaAlAs/GaAs	GaSe-CuInS ₂
Dy ₂ S ₃	GaAs-GaP	GaSe-SnO ₂
E..... (42)		
ErSi ₂	GaAs/Ge/Si	GaSeTe
EuLn ₂ S ₄	GaAs/Si	GaSrF/GaAs
EuO	GaAs-氮化锗	GaSSe
EuS	GaAs-金属	GaTe
EuSe	GaAs/天然氧化物	a-GaTe
F..... (42)		
F	GaAs-阳极氧化物	Ge
Fe	GaAsGe	a-Ge
Fe _x B _{100-x}	GaAsP	Ge-As-S
FeCl ₃	GaAsP-GaAs	a-Ge-As-Te
Fe(CO) ₅	GaAsP-GaInAsSb	Ge/Au
Fe ₂ O ₃	GaAsP/GaP	Ge:Be
<i>a</i> -Fe ₂ O ₃ /Si	GaAs _{1-x} P _x -GaAs _{1-y} P _y	Ge-Ga
G..... (42)		
Ga	GaAsSb	Ge/GaAs
Ga/AsCl ₃ /H ₂	GaAsSi	Ge/GaP
Ga-Mo-Si	GaInAlAs (用: AlGaInAs)	a-Ge:H
Ga-Si	GaInAlAs/InP	Ge-Pb-S
Ga-Te	GaInAs (用: InGaAs)	a-Ge-S
GaAlAs (用: AlGaAs)	GaInAs/AlInAs	Ge-Sb
	GaInAs/InP	Ge-Se ₂
	(用InGaAs/InP)	a-Ge-Se
	GaInAsP (用: InGaAsP)	Ge-Se-AI
	GaInAsP/GaInAsP	Ge-S-Bi
	GaInAsP/InP (用: InGaAsP/InP)	Ge-Se-Bi
	InP)	Ge-Si
	GaInAsSb	a-Ge-Si
	GaInP	Ge-Sn
	GaInP/GaAs	GeNiTe
	GaInSb	GeO ₂
	GaInSe	GeS

Ge(S, Se) ₂	In-Hg	多晶InSb	
GeSe ₂	In-In ₂ O ₃ -SnTe	InSb-(Al ₂ O ₃ +SiO ₂)	
a-GeSe ₂	In-PCl ₃ -H ₂	InSb/GaAs	
GeSe:Ag	In-Si	InSb-InTe	
GeSi	InAlAs (用: AlInAs)	InSbBi	
GeTe	InAs	InSe	
a-GeTe	InAs-AlSb	a-InSe	
GeTe-InTe	InAs-GaSb	In ₂ S ₃ -Y ₂ O ₃	
GeTeSSb	InAsP	InTe	
	InAsSb	a-InTe	
H..... (48)			
H	InAsSb-GaSb	In ₂ Te ₃ -Fe	
H ₂ -Ar	In _n CdI ₆	InTe ₃ -HgTe	
HCl	InGaAlAs (用: AlGaInAs)	Ir-V合金	
He	InGaAlP (用: AlGaInP)	ITO (钢锡氧化物)	
HF	InGaAlP/InGaP	ITO/CdS	
HF-NO ₂	InGaAs	ITO/CdS/InP	
Hg	InGaAs/GaAs	ITO/CdTe	
HgAgCrSe	InGaAs/InP	ITO/InP	
HgCdTe	InGaAsP	ITO/半导体	
HgCdTe-Al	InGaAsP/InGaAs/GaAs	ITO/Si	
HgCdTe/CdTe	InGaAsP/InP	K..... (53)	
HgCdSe	InGaAsSb	K	
HgCr ₂ Se ₄	InGaP/InAlP	Kr	
HgFeTe	In ₂ O ₃		
HgI ₂	In ₂ O ₃ /Si	L..... (53)	
Hg ₃ In ₂ Te ₆	InP		
HgMnSe	半绝缘InP		
HgMnTe	InP/BaSrF ₂ /InP	LaB ₆	
HgS	InP/氟化物/InP	γ -La ₂ S ₃	
a-HgS	InP/CaF ₂ /InP	Li	
H ₂ Se	InP:Co	LiInSe ₂ -GaP	
He/Si	InP:Fe	LiNbO ₃	
HgTe	InP/InGaAs/InP	Li ₂ O-ZnO-TiO ₂	
HgTe-MgTe	InP/InGaAsP/InGaAs	LnGeSe	
HgZnTe	InP/InGaAsP/InGaAs/InP	M..... (53)	
H ₂ O	InP/InP	M-CdSnAs ₂	
H ₂ O ₂	InP(Mn)	M-GaP	
	InP-Si	M-SiO ₂	
I..... (49)			
I ₂	InP/TiPdAu	Me ₃ In	
In	InPAs	Me ₃ In·PET ₃	
	InPAsSb	Me ₃ In·PM ₃	
	InPbSnTe	Me ₂ Zn	
	InPO ₄	Mg	
	InS		
	InSb		

Mg-Zn₃P₂
 MgO·Al₂O₃
 MgSiP
 Mn
 Mn-Mg
 Mn₂Sb₂O₇
 Mo
 Mo/GaAsP
 Mo/Si
 Mo/Ti
 Mo-镉硫族化物
 Mo₂N
 MoS₂
 MoSe₂
 MoSi₂
 MoSi₂/Si
 MoTe₂

N..... (54)

N₂
 N₂-Ar
 N-InP
 Na
 NaSbS₂-Sb₂S₃
 Nb
 NbN
 Nd
 Nd:YAG
 Ne
 NF₃
 NH₃
 NH₄Cl
 Ni
 Ni/Al
 Ni-Au
 Ni-Co-W-半导体
 Ni-Ge-Ni
 Ni-InP
 Ni/Sn-Pb
 NiO
 NiSi
 a-NiW

O..... (54)

O₃
 O-硝苯甲酯

P..... (56)

P
 PAsN
 Pb/Ge
 Pb-In-Au
 Pb/Sn
 PbCdS
 PbCdSe
 PbCdTe
 PbGeS
 PbGeTe
 Pb₂InNbO₆
 PbMnS
 PbMnTe
 PbS

多晶PbS
 PbS-CdS
 PbS-PbSe
 PbS-PbSe-PbTe
 PbS-PbTe
 PbS-Sb
 Pb₇S₂Br₁₀
 PbSe
 多晶PbSe
 PbSe-CdTe
 PbSe/PbSeTe
 PbSeTe
 PbSeTe/PbTe
 PbSnSe

PbSnSeTe-PbSeTe
 PbSnTe
 PbSnTe:In
 (PbSn)Te-Pb(Te, Se)
 PbSnTe/PbSeTe
 PbSnTe-PbTe
 Pb_{1-x}Sr_xS
 PbSSe
 PbSSe-Si
 PbSTe
 PbTe

多晶PbTe

PbTe-Ag₂Se
 PbTe-Bi
 PbTe-CdTe
 PbTe-Cu₂Se
 Pd
 Pd/Al
 Pb-Er
 Pd-GaAs
 Pd-InP
 Pd-Ni-Si-Be-B
 Pd-Si
 Pd-SiO₂-GaAs
 Pd-SiO₂-Si
 Pd₂Ge
 Pd₂Si
 Pd₂Si-AlCuSi
 Pd₂Si/Si
 PH₃
 Pt
 Pt/Al

Pt/Cu/Al
 Pt/GaAs
 Pt₄Ni₆Si
 PtSb₂
 PtSi
 PtSi/W/Al

R (56)

Rb₂Se₃
 Rb₂Te₃
 Ru

S (64)

S
 SAsAg
 Sb
 Sb-Se
 Sb₂O₃
 Sb₂S₃
 SbS
 Sb₂Se
 SbSSeI
 Sb₂Te₃
 S₂Cl₂
 Se

a-Se	Si-Pd	Si _x Se _{1-x}
a-Se-Ge/Ag	Si/Pd ₂ Si/Cr	Si-Se-In
Se/Te	Si-SiO ₂	Si-Sn-H
Se:Te:As	Si-SiO ₂ -Si ₃ N ₄	Si-SnO ₂ -Au
a-SeAsTe	Si-Si ₃ N ₄	Si/TiN
SeEt ₂	Si ₂ -Si ₃ N ₄ -Si	Si-Zn ₃ As ₂
SeGe/Ag	Si-SiC	Si ₂ Te ₃
SeTe	Si-电介质	Sm-GaSe
SF ₆	Si-金属	SmS
Si	Si-绝缘体	Sn
a-Si	Si-硅化物	α-Sn
a-Si:C	SiAl:H	Sn-Se
a-Si:Cl:H	SiC	SnO ₂
a-Si:F	a-SiC	SnO ₂ /Si
a-Si:F:H	a-SiC:H/a-Si:H	SnO ₂ /SiO _x /Si
a-Si:H	a-SiC:H/a-Si	SnP
a-Si:H/a-SiN:H	SiC/SiC/Si/Si	Sn ₂ P ₂ S
a-Si:H/甲醇	SiCl ₄	SnSe ₂
半晶硅	SiF ₄	SnTe
硅带	SiF ₄ /Cl ₂	SnTe/CdTe
硅粉	SiGe-GaAs	SnTe-Sb
硅晶须	a-SiGe:H	SnTe-ZnS
硅蹼	SiH ₄	Sr _{1-x} Ba _x F ₂ /InAs
多晶硅	SiH ₄ /H ₂	SrF ₂
半绝缘多晶硅	SiH ₄ +HCl	T..... (65)
多孔硅	SiH ₄ -HCl-H ₂	Ta
太阳电池级多晶硅	SiH ₄ -N ₂	Ta-Si
微晶硅	SiH ₄ -N ₂ -H ₂	Ta ₂ O ₅
冶金级硅	SiH ₄ -SiCl ₄	Ta ₂ O ₃ /Si
a-Si-Ge	SiN	TaSi ₂
a-Si-Si ₃ N ₄	a-SiN	TaSi ₂ -GaAs
a-Si-SiO ₂	SiN:H	TaSi ₂ /多晶硅
多晶硅-硅	a-SiN:H	Te
多晶硅-SiO ₂	Si ₃ N ₄	Te/CdS
多晶硅/TaSi ₂	a-Si ₃ N ₄	Te-Se
Si-Ag	Si ₃ N ₄ -Al ₂ O ₃ -AlN	Te-TeO ₂
Si-AlGaAs	SiO	Ti
Si-As	a-SiO	Ti/CrO-Cr/Cu/Cr
Si-Au	SiO ₂	Ti/TiO ₂ /Au
Si-Bi	a-SiO ₂	Ti/TiO ₂ /金属结构
Si-CoSi	多孔氧化硅	Ti-W
Si-Ga	SiO ₂ -GaInAs	Ti-W/Au
Si/GaP	SiO ₂ :Si ₃ N ₄	Ti:LiNbO ₃ -InGaAsP
Si-Ge	SiO-TiO	Ti _x C
Si-In	Si-Sb	
Si/MgO-Al ₂ O ₃ /SiO ₂ /Si		

TiN		X..... (65)	ZnSe-H ₂ -惰性气体
TiNi			ZnSe:Mn
TiO ₂	Xe		ZnSe-ZnCdTe
TiS ₂	XeCl		ZnSe-(Zn _{1-x} Cd _x Te) _{1-x} (In ₂ Te ₃) _x
TiSi ₂	XeF ₂		ZnSeTe
Tl		Y..... (65)	ZnSiAs
Tl ₃ AsSe ₃			ZnSiP
Tl ₄ AsSe ₂ -AsSe	Yb		ZnSnP
TlAsSe ₂ -Se	YbGa ₂ Se ₄		ZnSSe
TlAsSe ₂ -Tl	Yb ₂ O ₃		ZnTe
TlCdI ₃	Yb ₂ S ₃		ZnTe-CdTe
Tl ₄ CdI ₆	(Y ₂ O ₃) _m (ZrO ₂) _{1-m}		ZnTeSe
TlGaS ₂		Z..... (65)	Zr
TlGaS ₂ -Nd ₂ S ₃			ZrN
TlGaSe ₂	Zn		V族元素
TlGaSe ₂ -Nd ₃ -Nb ₂ Se ₃	Zn-ZnO-Ag		A ₂ I B ^{IV} C ₃ ^{VI} 化合物
TlGaTe ₂	Zn ₂ Ba ₂ Fe ₁₂ O ₂₂		A ₄ I B ₃ ^{IV} C ₃ ^{VI}
TlInS ₂	(Zn _x Cd _{1-x})S/Si		A I B ^{IV} 族化合物
TlInSe ₂	ZnCdSe		A I B ^{IV} 化合物
TlInTe ₂	ZnCdTeSe		A ₂ II B ^{IV} C ₃ ^{VI} 化合物
TlInTe ₂ -TlSmTe ₂	ZnCr ₂ Se ₄		A II B ^{IV} 化合物
Tl ₂ S-Tl ₂ Se-Tl ₂ Te	ZnGaAs ₂		A ^{VI} B ^{IV} 化合物
TlSbSe ₂	ZnGeAs ₂		I - VI 族三元化合物
TlSe	a-ZnGeAs ₂		II - V 族三元化合物
Tl ₂ Se-As	ZnGeP		II - V 族四元化合物
TlSSe	ZnInS		(A _x B _y C _{1-x-y} D)
TlTe	ZnInSe		半导体
TmSeTe	ZnMnSe		半导体-半金属
	ZnMnTe		半导体-电介质
V	ZnO		半导体-介质-半导体
VO ₂	ZnO-B ₂ O ₃ -SiO ₂		半导体合金
V ₂ O ₃	ZnP ₂		半导体金刚石
a-V ₂ O ₅	ZnS		半金属
V ₃ Si	ZnS:Cu:Cl:Er		半无限半导体
VSi ₂ /Si	ZnS:Cu, Er		苯
	ZnS:ErF ₃		本征半导体
	(ZnS) _{1-x} (GaP) _x		变带半导体
W..... (65)	ZnS:Mn		表面活性物质
W	ZnS:Sn		玻璃
W/Al	ZnS:TbF ₃		玻璃半导体
W/Au	ZnS:YbF ₃		玻璃半导体-金属
W-Ge	ZnSe		玻璃-金属
WO ₃	多晶ZnSe		补偿半导体
WSi ₂	ZnSe/CdSe		部花青
WSi _x /GaAs			不锈钢
			掺杂半导体

层状半导体	硅化物	烯氧化物(PMMA-PEO)
磁性半导体	硅化物/多晶硅	聚硅氧烷
氮化物	贵金属	聚合物
导电聚合物	硅酮	聚噻吩
导电氧化物	硅橡胶	聚四氟乙烯
等离子体聚合物	过渡金属	聚合物-SiO ₂
等离子体共聚合甲基丙 烯酸甲酯四甲基锡PP (MMA-TMT)	过渡金属硅化物	聚乙炔
等离子体氯化硅	合金	聚乙炔/聚硅氧烷
电介质	黑磷	聚酰亚胺
电子材料	红宝石	绝缘体
多晶半导体	化合物半导体	绝缘体-电解质
多晶金刚石	化合物半导体-聚合物	空气
多晶硅化物	黄铜矿(ABC)	蓝宝石
多晶体	灰锡	类金刚石半导体
多烯	混晶半导体	离子半导体
惰性气体	极性半导体	离子晶体
二甲基镓	激子-杂质络合物	六氟丁基丙烯酸酯-甘油
二聚物	甲基丙烯酸甲酯	醇丙烯酸酯共聚物(FBMG)
二氯硅烷	甲醇	磷硅玻璃
二乙基铍	尖晶石	磷光体
二乙基碲	尖晶石-硅	磷化铂
反铁磁半导体	简并半导体	磷酸钒玻璃-铋金属系统
非极性半导体	间接带隙半导体	磷酸锌镉玻璃
非晶金属-半导体	碱金属	硫属化合物
非均匀半导体	金刚石	汞硫属化合物
非线性半导体	a-金刚石	镉硫属化合物
酚醛树脂	金属	铅硫族化合物
氟化物-半导体	金属-半导体	锌硫族化合物
氟氧化物	金属-电介质-半导体	铕硫族化合物
富In合金	金属-聚酰亚胺	无定形硫属化合物
高温半导体	金属-化合物半导体	硫化镧
高阻半导体	金属-硫属化合物	硫化镱
钢	金属-Ag ₃ AsS ₃ (Ag ₃ SbS ₃)-金属	卤化银
各向异性半导体	金属-AlN-Si	卤化物
共价半导体	金属/a-Si/ITO	氯甲化聚苯乙烯
共聚物	金属-SiO _x	络合物
固体	金属-a-Si:H	难熔金属
光导体	金属/InP	耐熔金属硅化物
光电子材料	金属-Si	硼硅玻璃
光伏材料	金属硅化物	硼磷硅酸盐(BPSG)
光学记录材料	金属-酞花菁	硼微晶玻璃(PWB)
硅化铒	金属有机化合物	气体
硅化铌	聚苯基乙炔	纤锌矿
硅化钛	聚吡咯-半导体	氢化物
	聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)	去离子水
	聚甲基丙烯酸甲酯-聚乙	染料

有机染料	羰基铁	氧化锆
热电材料	碳化硼	氧化镱
热固性聚合物	陶瓷	氧化氮化氧化物
热塑性聚合物	铁	氧氮化硅
三甘氨酸硫酸盐(TGS)	铁磁性半导体	氧氮化物
三甲基镓[(CH ₃) ₃ Ga]	铁电半导体	液氮
三甲基铝	铁电体	液态金属
三甲基砷	铁氧体	液体
三甲基铟	无定形半导体(含: 非晶半导体)	乙二醇
三元合金半导体	无定形硅基合金	乙硅烷
三乙醇胺	无机-有机半导体	钇铁石榴石
三乙基镓	无机物	荧光体
三乙基砷	无隙半导体	有机半导体
三乙基铟	微晶	有机化合物/硅
三氯乙烯	稀土化合物	有机物
水蒸汽	稀土金属	元素半导体
闪锌矿半导体	稀土元素	云母
石墨	压电半导体	杂质半导体
石英	氧化物	窄带半导体
熔融石英	天然氧化物	直接能带半导体
四方半导体	天然氧化物/A _m B _n	驻极体/半导体
四元半导体合金	阳极氧化物	重氨基化合物
四乙基锡	氧化物-半导体	
碳树脂系	氧化铒	

主题词一览表

A..... (74)

ALAS程序
Anicon公司
AT & T Bell实验室
 α 粒子
爱因斯坦关系
安全系统
安装
奥地利

B..... (74)

BASIC程序
BIPOLE程序
BFGS程序
靶
巴西
半导体车间
半导体电子学
半导体方程
半导体工厂
半导体工业
半导体激光器 (含: 激光二极管)
GRIN-SCH激光器
V槽衬底激光器
场效应激光器
大功率激光器
大光腔(LOC)激光器
单模激光器
电子束抽运激光器
短腔激光器
分布布喇格反射(DBR)激光器
分布反馈(DFB)激光器
复合腔激光器
干涉激光器
沟道衬底激光器
横向结条形(TJS)激光器
集成激光器
脊形波导激光器
可见光激光器

可调谐激光器	半导体物理学
拉曼激光器	半导体细丝
连续波激光器	半导体阳极
量子阱异质结(QWH)激光器	半透膜
耦合腔激光器	版图
双波长激光器	曝光 (参: 光刻, 复印)
双异质结(DH)激光器	电子束曝光
双有源层(DAL)弯曲激光器	离子束曝光
锁模激光器	投影曝光
台阶衬底(TS)激光器	紫外线曝光
台面激光器	曝光表
条形激光器	曝光系统
外腔激光器	电子束曝光系统
相控阵激光器	分步重复曝光机
肖特基势垒异质结(SBH)激光器	投影曝光装置
隐埋光学波导激光器	保护
隐埋新月形激光器	存储保护
隐埋异质结(BH)激光器	过压保护
异质结激光器	保护电路
增益导引激光器	保护环
折射率导引激光器	背面选通效应
质子轰击条形激光器	倍频器
注入激光器	倍增器
半导体激光器阵列	本征数
半导体器件	本征态
超晶格器件	比较器
非线性器件	比例缩小
高速器件	比热
高温器件	闭管法
高压器件	闭锁效应
光电器件(另立主题)	变分法
功率器件	变换器(含: 转换器)
热载流子器件	模/数(A/D)变换器
三维器件	数/模(D/A)变换器
双极器件	频率发射变换器
体效应器件	变频器
微波器件	FET变频器
亚微米器件	变阻器
转移电子器件(TED)	编程
	电子束编程
	熔丝编程
	编码-译码器(CODEC)

边界条件	布局编辑器	汽相掺杂
边缘效应	布里渊区	调制掺杂
标准	布线(含: 走线; 参: 布局)	选择掺杂
标准单元	多层布线	中子嬗变掺杂
标准化		自掺杂
标准具		掺杂剂
表面	CDP1800系列	掺杂分布
表面波	CDP 1804A	掺杂浓度
表面波纹	C-G-V法	掺杂条纹
表面重构	C-V法	场效应
激光感生表面重构	C-V特性	场致发射
表面处理	彩色电视机	超导性
表面反应	参数分析仪	超晶格
表面分析	操作系统	超精细结构
表面化学	测定	超高压
表面能	测辐射热计	超声波
表面声波	测量	超声衰减
表面声学	光声测量	超声振动
表面态	光学测量	车间
表面弹性波元件	电学测量	尘粒
表面效应	非破坏性测量	衬底
表面形貌	霍耳测量	衬度
表面性质	热学测量	沉淀(含: 沉积)
波长	无接触测量	乘法器
波导	测试	成本
波函数	电子束测试	成核
波谱学	计算机辅助测试(用: 计算机)	成品率
波纹管	在线测试	成像
波形	自测试(含: 自动测试)	程序
波阵面	测试结构	编译程序
玻耳兹曼分布	测试码	子程序
玻耳兹曼方程	测试设备	测试程序
伯格斯矢量	电子束测试系统	尺寸量子化
剥离	测试图形	尺寸效应
薄膜电路	层错	弛豫
薄膜电阻	氧化感生堆垛层错(OSF)	自旋弛豫
补偿	层错法	自旋晶格弛豫
自补偿	插件板	弛豫时间
补偿电路	插座	重复性
补偿度	掺杂	瞬
补码	电化学掺杂	出错
不均匀性	反掺杂	处理器(含: 信息处理器)
不稳定牲	光掺杂	多处理器
布达佩斯技术大学	激光掺杂	傅里叶变换处理器
布局	接触掺杂	浮点处理器
自动布局	离子掺杂	数字信号处理器

C..... (79)

图象处理器	磁光性质	随机存取存储器 (RAM)
向量处理器	磁化	相联存储器
外围处理器	磁化率	只读存储器 (ROM)
微处理器	磁化学	虚拟存储器
中央处理器	磁控管	约瑟夫逊存储器
阵列处理器	磁敏性	只读存储器 (ROM)
除法器	磁浓缩效应	准静态随机存取存储器
触发	磁热电性质	存储器阵列
触发器	磁吸收	存储时间
传播	磁学性质	存储效应
传感器 (参: 探测器)	磁压阻	光感生存储效应
CCD传感器	磁阻	D..... (86)
ISFET传感器	负磁阻	DCFL电路
MOS传感器	纵向磁阻	DOE/SERI (美国能源部/太阳能 研究所)
pH值传感器	粗糙度	大信号模式
触觉传感器	猝灭	代码
电流传感器	场猝灭	带宽
光传感器	热猝灭	单粒子效应
化学传感器	光学猝灭	单模工作
霍耳传感器 (参: 霍耳器件)	催化	单片集成
集成传感器	催化剂	单频发射
功率传感器	淬火	单元库
气体传感器	存取	氮化
燃烧敏感元件	存储	等离子体氮化
色传感器	光学存储	离子束氮化
生物传感器	存储单元	热氮化
湿度传感器	约瑟夫逊存储单元	阳极氮化
图象传感器 (参: 摄象器)	存储器	稻壳
温度传感器	CCD存储器	导电类型
压力传感器	EAROM (电可改写只读存储 器)	导纳
传感器阵列	EEPROM (电可抹可编程只 读存储器)	导通特性
传感特性	EEROM (电可抹只读存储器)	倒相器 (用: 反相器)
传片	EPROM (可抹可编程只读存 储器)	倒装
传输线	NOVRAM	德意志民主共和国
穿孔结构	PROM (可编程只读存储器)	氘灯
穿通	电子束PROM	等离激光
串音	SEEPROM	表面等离激光
纯度	动态随机存取存储器(DRAM)	等离子体
磁场	非易失存储器	磁等离子体
量子化磁场	高速缓冲存储器	磁控管等离子体
磁场电效应	光电子存储器	电子-空穴等离子体
磁场效应	静态随机存取存储器(SRAM)	激光等离子体
磁带	冗余存储器	θ-收缩等离子体
磁冻结区		等离子体加工
磁导率		等离子体硬化
磁光效应		

等离子体传播	电荷损耗	阈值电流
等离子源	电荷态	亚阈值电流
等效电路	电荷注入	注入电流
低频特性	电荷转移	电流发生器
滴定法	电荷转移器件	电流起伏
电-光特性	表面沟道CCD	电流失配
电场	斗链器件 (BBD)	电流收集
电磁波	电荷耦合器件 (CCD)	电流注入
电磁效应	红外CCD (IRCCD)	电路模型
电导	埋沟CCD	电路综合
表面电导	电话	电迁移
电子电导	电化学	电容
非欧姆电导	电极	光电容
非线性电导	光电极	结电容
负电导	隧道电极	栅-漏电容
负微分电导	透明电极	瞬态电容
沟道电导	电离	电容器
激子电导	碰撞电离	MIS电容器
交流电导	光致电离	MOS电容器
离子电导	热电离	超晶格势垒电容器
量子电导	电离能	存储电容器
热激电导	电离系数	电解电容器
瞬态电导	电连接	耦合电容器
输出电导	电流	去耦电容器
隧道电导	暗电流	电视
跳跃电导	衬底电流	电视变换器
微分电导	电子束感生电流 (EBIC)	电声反射
杂质电导	短路电流	电声效应
电导率	反向电流	电位
暗电导率	复合电流	电位分布
霍耳电导率	光电化学电流	电物理性质
电镀	光电流	电吸收
电反射	基极电流	电学特性
电光效应	激光感生电流 (LBIC)	电学性质
电光性质	集电极电流	电压
电荷	空间电荷限制电流	电子束感生电压
表面电荷	空穴电流	光电压
电子束感应电荷	离子电流	霍耳电压
固定电荷	漏泄电流	击穿电压
界面电荷	热激电流	开路电压
空间电荷	栅电流	漏极电压
电荷存储	声电流	平带电压
电荷抽运	隧道电流	栅电压
电荷收集	瞬态电流	声电压
电荷密度	位移电流	通态电压
电荷密度波	温差电流	阈值电压